
	<h2 style="color: red;">SI5517DU-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5517DU-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V 6A CHIPFET</p> <p>Datenblätter:  SI5517DU-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






Spezifikationen

Teilenummer	SI5517DU-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 6A CHIPFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® ChipFet Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 4.4A, 4.5V
Leistung - max	8.3W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® ChipFET™ Dual
Andere Namen	SI5517DU-T1-E3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 8V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 20V 6A 8.3W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A
Basisteilenummer	SI5517

SI5517DU-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5517DU-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5517DU-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5517DU-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5517DU-T1-GE3DKR-ND SILI SI5517DU-T1-GE3DKR-ND SILI</p>	 <p>SI5515DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p>SI5515DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p>SI5517DU-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 6A CHIPFET</p>
 <p>SI5515DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p>SI5515DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p>SI5517DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 6A CHIPFET</p>	 <p>SI5519DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 6A CHIPFET</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5517DU-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5517DU-T1-E3 Datenblatt	SI5517DU-T1-E3-Datenblätter	SI5517DU-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5517DU-T1-E3
SI5517DU-T1-E3 Electronic	SI5517DU-T1-E3-Komponenten	SI5517DU-T1-E3-Verteiler	SI5517DU-T1-E3-Bild	SI5517DU-T1-E3-Teil
SI5517DU-T1-E3 Preis	SI5517DU-T1-E3 Hersteller	SI5517DU-T1-E3 Bild	SI5517DU-T1-E3 Aktie	SI5517DU-T1-E3 Inventar
SI5517DU-T1-E3 Neu	SI5517DU-T1-E3 Original	SI5517DU-T1-E3 garantiert	SI5517DU-T1-E3 RFQ	SI5517DU-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited